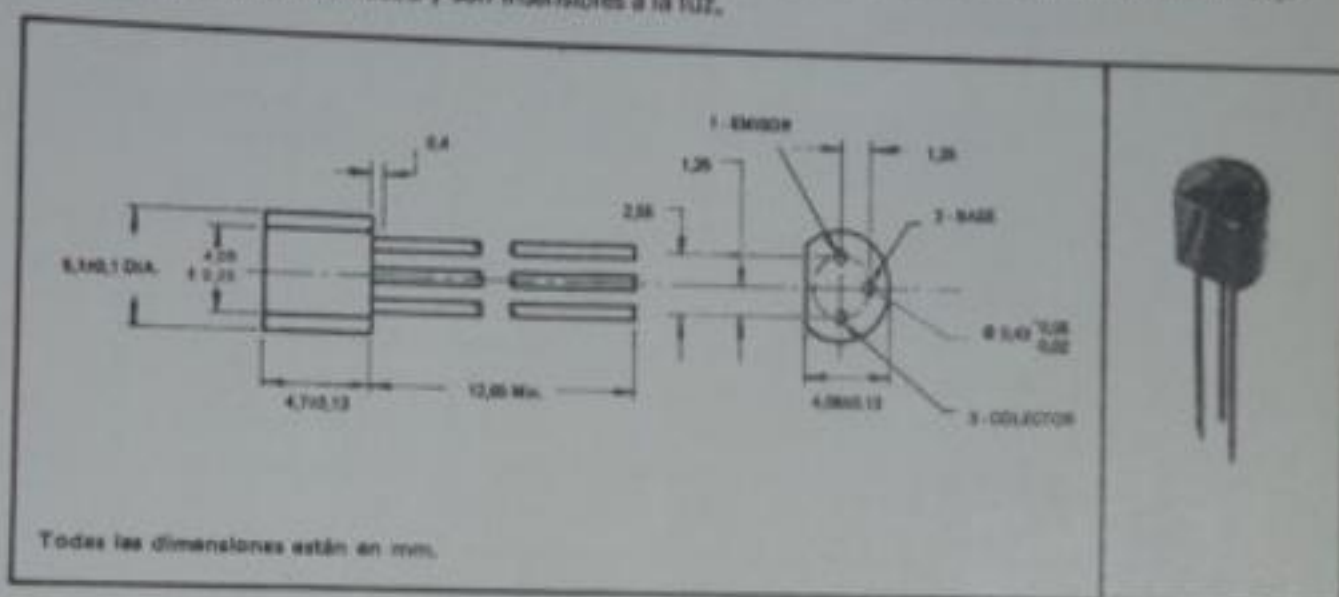


TRANSISTORES DE ALTA TENSION

- TV - AMPLIFICADORES DE SALIDA DE VIDEO
- AMPLIFICADORES OPERACIONALES
- INVERSORES DE ALTA TENSION
- REGULADORES DE TENSION

INFORMACION MECANICA

Estos transistores están encapsulados en un compuesto plástico específicamente formulado para tal fin, utilizando un proceso altamente mecanizado desarrollado por Texas Instruments. La cápsula soporta temperaturas de soldadura sin deformación. Estos dispositivos presentan características estables bajo condiciones de alta humedad y son insensibles a la luz.



VALORES MAXIMOS ABSOLUTOS A 25°C DE TEMPERATURA AMBIENTE (SALVO INDICACION CONTRARIA)

	2A297	2A298	2A299
Tensión Colector-Base	160 V	250 V	300 V
Tensión Colector-Emisor (Ver Nota 1)	160 V	250 V	300 V
Tensión Emisor-Base	5 V	6 V	7 V
Corriente Continua del Colector		150 mA	
Disipación Continua del Dispositivo a (o debajo) 25°C de Temperatura Ambiente (Ver Nota 2)		800 mW	
Disipación Continua del Dispositivo a (o debajo) 25°C de Temperatura del Terminal (Ver Nota 3)		1.25 W	
Disipación Continua del Dispositivo a (o debajo) 25°C de Temperatura de Cápsula y Terminal (Ver Nota 4)		1.6 W	
Rango de Temperatura de Almacenamiento		-65°C a 150°C	
Temperatura en Terminales a 1,6 mm de la Cápsula Durante 10 Segundos		200°C	

NOTAS:

1. Este valor se aplica cuando el diodo base-emisor está a circuito abierto.
2. Decece linealmente hasta 150°C de temperatura ambiente a razón de 6,4 mW/°C.
3. Decece linealmente hasta 150°C de temperatura del terminal a razón de 10 mW/°C. La temperatura del terminal se mide en el terminal de colector a 1,6 mm. de la cápsula.
4. Este valor se aplica cuando la cápsula entera (incluyendo terminal) se mantiene a 25°C. Decece linealmente hasta 150°C de temperatura de cápsula y terminal a razón de 12,8 mW/°C.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS A 25°C DE TEMPERATURA AMBIENTE (SALVO INDICACION CONTRARIA)

PARAMETRO	CONDICIONES DE PRUEBA	2A297			2A298			2A299			UNID
		MIN	TIP	MAX	MIN	TIP	MAX	MIN	TIP	MAX	
$V_{BR(CB)}$	Tensión de Ruptura C-B	$I_C = 100 \mu A, I_E = 0$			150			250			V
$V_{BR(CE)}$	Tensión de Ruptura C-E	$I_C = 2 mA, I_E = 0$			150			250			V
$V_{BR(EB)}$	Tensión de Ruptura B-E	$I_E = 100 \mu A, I_C = 0$			5			6			V
I_{CBO}	Corriente de Corte de Colector	$V_{CB} = 100 V, I_E = 0$			100						nA
		$V_{CB} = 200 V, I_E = 0$						100			nA
		$V_{CB} = 250 V, I_E = 0$						100			nA
I_{EBO}	Corriente de Corte de Emisor	$V_{EB} = 3 V, I_C = 0$			50			50			nA
P_{FE}	Ganancia de Corriente Estática	$V_{CE} = 10 V, I_C = 5 mA$			10			10			
		$V_{CE} = 30 V, I_C = 10 mA$			30			150			
		$V_{CE} = 10 V, I_C = 100 mA$			10			10			
		$V_{CE} = 25 V, I_C = 30 mA, T_{JA} = 55^\circ C$			10						
V_{BE}	Caída de Tensión B-E	$I_E = 3 mA, I_C = 30 mA$			0,85			0,85			V
$V_{CE(sat)}$	Tensión Colector Emisor de Saturación	$I_E = 3 mA, I_C = 30 mA$			1			1			V
$ h_{FE} $	Ganancia de Corriente en Pequeña Señal	$V_{CE} = 25 V, I_C = 10 mA, f = 10 MHz$			15			15			dB
C_{11e}	Capacitancia de Entrada en Emisor Común	$V_{CB} = 0,5 V, I_E = 0, f = 1 MHz$			25			25			pF
C_{12e}	Capacitancia de Realimentación en E-Común	$V_{CB} = 30 V, I_E = 0, f = 1 MHz$			4			4			pF
C_{22e}	Capacitancia de Salida en Emisor Común	$V_{CB} = 30 V, I_E = 0, f = 1 MHz$			5,5			5,5			pF

INFORMACION TERMICA

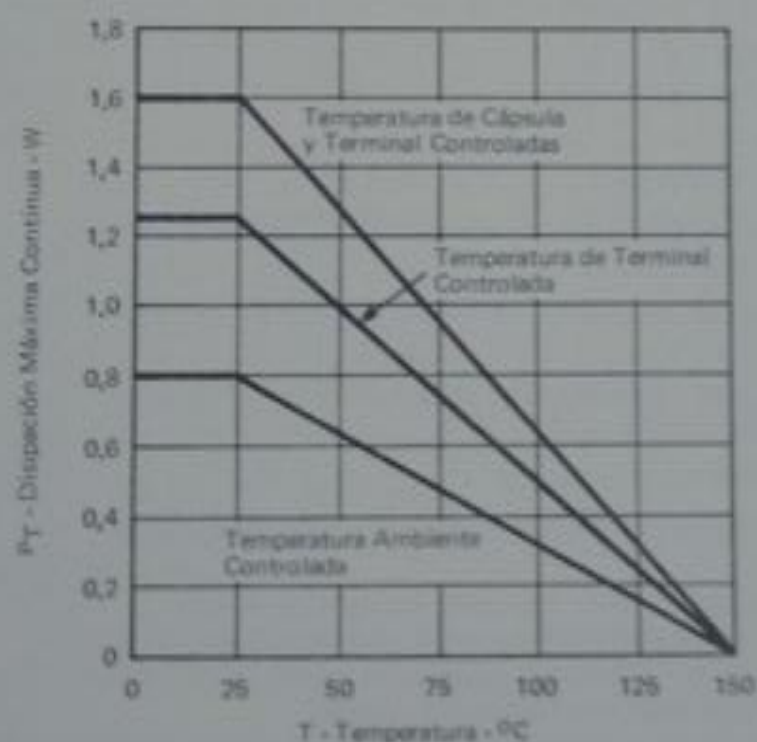


FIGURA 1